

○ 低周波電力増幅用

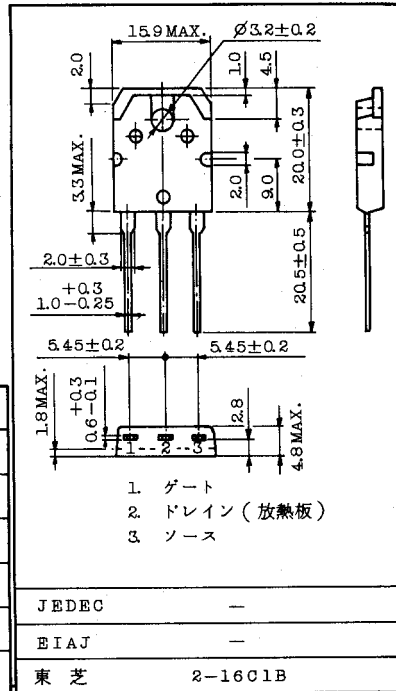
単位：mm

## 特 長

- ・ 高耐圧です。  $V_{DSS}=160V$
- ・ 高順方向伝達アドミタンスです。  $|Y_{fs}|=2.0S$  (標準)
- ・ 2SJ115 とコンプリメンタリになります。

最大定格 ( $T_a=25^\circ C$ )

項 目	記 号	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧	$V_{DSS}$	160	V
ゲート・ソース間電圧	$V_{GSS}$	$\pm 20$	V
ドレイン電流	$I_D$	8	A
許容損失 ( $T_c=25^\circ C$ )	$P_D$	100	W
チャネル温度	$T_{ch}$	150	$^\circ C$
保 存 温 度	$T_{stg}$	$-55 \sim 150$	$^\circ C$

電氣的特性 ( $T_a=25^\circ C$ )

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
ゲート漏れ電流	$I_{GSS}$	$V_{DS}=0, V_{GS}=\pm 20V$	—	—	$\pm 1.0$	$\mu A$
ドレイン・ソース間降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D=5mA, V_{GS}=0$	160	—	—	V
ゲート・ソース間しき断電流	$V_{GS(OFF)}$ (注)	$V_{DS}=10V, I_D=0.1A$	0.8	—	2.8	V
ドレイン・ソース間飽和電圧	$V_{DS(ON)}$	$I_D=5A, V_{GS}=10V$	—	2.5	7.0	V
順方向伝達アドミタンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS}=10V, I_D=2A$	1.0	2.0	—	S
入 力 容 量	$C_{iss}$	$V_{DS}=10V, V_{GS}=0, f=1MHz$	—	430	—	pF
出 力 容 量	$C_{oss}$	$V_{DS}=10V, V_{GS}=0, f=1MHz$	—	260	—	pF
帰 還 容 量	$C_{rs}$	$V_{DS}=10V, V_{GS}=0, f=1MHz$	—	80	—	pF

(注)  $V_{GS(OFF)}$  区分 0 : 0.8~1.6, Y : 1.4~2.8

この製品はMOS構造ですので取扱いの際には静電気にご注意ください。